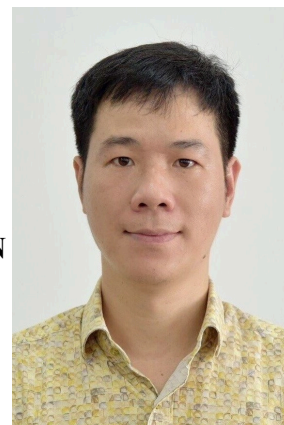


**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

**BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN**  
**CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ**  
**Mã hồ sơ:.....**



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: )

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu

### A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Ngô Ngọc Hà

2. Ngày tháng năm sinh: 19/10/1979; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Tổ 7, Cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số 1, Ngách 211/88 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0913511001;

E-mail: ha.ngongoc@phenikaa-uni.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 06,2012 đến tháng, năm 11,2021: Giảng viên tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ tháng, năm 11,2021 đến tháng, năm 07,2024: Giảng viên tại Trường Đại học Phenikaa

Chức vụ hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Phenikaa

Địa chỉ cơ quan: Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường ĐH Công nghiệp Việt-Hung, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Trường ĐH Giao Thông Vận tải

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Trường ĐH Giao Thông Vận tải

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 22 tháng 06 năm 2001, số văn bằng: B322925, ngành: Khoa học Vật liệu, chuyên ngành: Vật liệu điện tử

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 01 tháng 12 năm 2003, số văn bằng: I0105, ngành: Khoa học Vật liệu, chuyên ngành: Vật liệu điện tử

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 20 tháng 04 năm 2012, số văn bằng: 15878, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Quang điện tử bán dẫn

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Amsterdam, Vương quốc Hà Lan

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HDGS cơ sở: Trường Đại học Phenikaa

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HDGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- *Quang tử bán dẫn Si và ứng dụng.*

- *Vật liệu quang, điện tử trên cơ sở các loại bán dẫn đa thành phần và ứng dụng.*

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 4 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 2 cấp Nhà nước; 1 cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 42 bài báo khoa học, trong đó 27 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam	Hội Vật lý Việt Nam	2018
2	Chiến sĩ thi đua	Trường Đại học Bách Khoa	2014
3	Chiến sĩ thi đua	Trường Đại học Bách Khoa	2015

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

## B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Ứng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một giảng viên tại các đơn vị công tác. Ứng viên tự đánh giá đủ tiêu chuẩn để được công nhận chức danh Phó Giáo sư theo các thông tư hướng dẫn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 12 năm 1 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)	
		Chính	Phụ			ĐH	SDH		
1	2015-2016	1	1	1			225	225/345/270	
2	2018-2019	1	1	1			135	135/255/229.5	
3	2020-2021						133	90	223/268/229.5
03 năm học cuối									
4	2021-2022						221	45	266/283.5/270
5	2022-2023						219	45	219/270.9/270
6	2023-2024						150	130	280/424.5/270

(\*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; Tại nước: Vương quốc Hà Lan năm 2012

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BS NT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVC H/CK 2/BSN T	Chính	Phụ			
1	Trương Thị Thanh Thủy		X	X		06/2014 đến 12/2014	Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội	28/03/2016
2	Nguyễn Văn Kiên		X	X		04/2015 đến 10/2015	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	30/06/2016
3	Nguyễn Thị Ngọc Lâm		X	X		03/2017 đến 10/2017	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	12/10/2018
4	Trần Thị Thùy Dương		X	X		02/2018 đến 10/2018	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	30/12/2019
5	Nguyễn Trường Giang	X		X		05/2015 đến 05/2018	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	02/10/2019
6	Lê Thành Công	X			X	05/2015 đến 05/2018	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	26/08/2022

**Ghi chú:** Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ tran g ... đến tran g)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Không có							

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ( )

**Lưu ý:**

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

## 6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Nghiên cứu hiệu ứng nhân hạt tải điện trong Ge và SiGe nanô tinh thể trên nền vật liệu vùng cấm rộng	CN	103.02.2012.4 1, cấp Nhà nước	15/02/2013 đến 15/02/2016	28/12/2016/ Đạt
2	Nghiên cứu phát triển vật liệu phát quang dải bước sóng hồng ngoại gần trên cơ sở Si và Ge cấu trúc nano	CN	103.02.2017.3 8, cấp Nhà nước	15/12/2017 đến 15/12/2019	16/12/2021/ Đạt
3	Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang điện Si-Ge hiệu suất cao	CN	B2016 BKA 31, cấp Bộ	1/1/2016 đến 31/12/2017	13/08/2020/ Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

## 7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Optical properties of Si/Si:Er multilayer structures grown by SMBE method	3	Có	Physica B: Condensed Matter	Uy tín - ISI IF: IF = 2.8, Q2		23-24, 404, 5132-5135	12/2009
2	Metalorganic chemical vapor deposition of Er-doped ZnO thin films with 1.54 μm	6	Không	Journal of Physics: Conference Series	Uy tín - ISI IF: IF = 0,48; Q4	3	156, 012027	05/2009

	photoluminescence							
3	Photonic properties of Er-doped crystalline silicon	3	Không	Proceedings of the IEEE	Uy tín - ISI <i>IF: IF = 10.694, Q1</i>	75	97, 7, 1269 - 1283	06/2009
4	Optical gain of the 1.54 $\mu$ m emission in MBE-grown Si:Er nanolayers	4	Có	Physical Review B	Uy tín - ISI <i>IF: IF = 3.62, Q1</i>	30	81, 19, 195206	05/2010
5	Evaluation of free carrier losses to 1.54 $\mu$ m emission in Si/Si:Er nanolayers on SOI substrate for optical gain observation	3	Có	Optical Materials	Uy tín - ISI <i>IF: IF = 3.908, Q2</i>	2	33, 7, 1094-1096	05/2011
6	Photon cutting for excitation of Er <sup>3+</sup> ions in SiO <sub>2</sub> sensitized by Si quantum dots	8	Có	Physical Review B	Uy tín - ISI <i>IF: IF = 3.62, Q1</i>	18	84, 24, 241308(R)	12/2011
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
7	Quá trình phân cắt lượng tử trong hạt nano tinh thể Si - Cơ chế kích thích đồng thời hai ion đất hiếm Er <sup>3+</sup>	1	Có	Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật			103 93-97	10/2014
8	PHỔ HUỖNH QUANG CỦA MÀNG NANOCOMPOSITE SiO <sub>2</sub> -SnO <sub>2</sub> PHA TẠP Eu <sup>3+</sup>	3	Không	Kì yếu Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần IX - SMPS2015			2 485-488	11/2015

9	Single phase Si <sub>1-x</sub> Gex nanocrystals and the shifting of the E1 direct energy transition	7	Có	Nanotechnology	Uy tín - ISI IF: IF = 3.5, Q1 - 2015	16	26, 37, 375701	08/2015
10	Correlation between SnO <sub>2</sub> nanocrystals and optical properties of Eu <sup>3+</sup> ions in SiO <sub>2</sub> matrix: Relation of crystallinity, composition, and photoluminescence	4	Có	Journal of Luminescence	Uy tín - ISI IF: IF = 3.6, Q2	15	163 28-31	05/2015
11	Magnetic properties of sol-gel synthesized C-doped ZnO nanoparticles	7	Không	Journal of Alloys and Compounds	Uy tín - ISI IF: IF = 6.2; Q1	42	668 87-90	05/2016
12	Tuning the Electronic Structure of Si <sub>1-x</sub> Gex Alloys	3	Không	VNU Journal of Science: Mathematics Physics			32, 4, 57-62	12/2016
13	Hydrothermal synthesis and characteristic photoluminescence of Er-doped SnO <sub>2</sub> nanoparticles	6	Không	Physica B: Condensed Matter	Uy tín - ISI IF: IF = 2.8, Q2	16	501 34-37	05/2016
14	Nanocrystal growth of single-phase Si <sub>1-x</sub> Gex alloys	5	Có	Journal of Physics and Chemistry of Solids	Uy tín - ISI IF: IF = 4.0; Q2	14	93 121-125	03/2016
15	Investigation of optical gain in Eu-doped GaN thin film grown by OMVPE method	4	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Uy tín - SCIE IF: IF = 8; Q1	8	1, 2, 220-223	06/2016

16	Influence of Composition, Doping Concentration and Annealing Temperatures on Optical Properties of Eu <sup>3+</sup> -Doped ZnO-SiO <sub>2</sub> Nanocomposites	5	Không	Journal of Nanoscience and Nanotechnology	Uy tín - SCIE IF: IF = 1.354, Q3	7	16, 8, 7955-7958	08/2016
17	Spectral probing of carrier traps in Si-Ge alloy nanocrystals	5	Có	Physica status solidi (RRL)-Rapid Research Letters	Uy tín - ISI IF: IF2016=3.03, Q1 2016	4	10, 11, 824-827	11/2016
18	Magnetic Properties of C-doped ZnO Nanoparticles and Stoner Model of Ferromagnetism	3	Không	Proceedings ICAMN2016 - The 3th International conference on advanced materials and nanotechnology			1 355-359	11/2016
19	Influence of Hydrothermal Temperature on the Optical Properties of Er-Doped SnO <sub>2</sub> Nanoparticles	6	Không	Journal of electronic materials	Uy tín - SCIE IF: IF = 1.8, Q2	4	46 3341-3344	06/2017
20	Controlling of the diameter and density of silicon nanowires prepared by silver metal-assisted chemical etching	5	Có	The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017)			1 223	11/2017
21	Microscopic and optical parameters of Eu <sup>3+</sup> -doped SnO <sub>2</sub> -SiO <sub>2</sub> nanocomposites	4	Có	Journal of Luminescence	Uy tín - ISI IF: IF = 3.28; Q2	5	201 129-134	09/2018



	prepared by sol-gel method							
22	In situ observation of phase transformation in iron carbide nanocrystals	6	Không	Micron	Uy tín - ISI $IF: IF = 2,4; Q2$	5	104 61-65	01/2018
23	Development Of Silicon Germanium Alloys For Silicon-Based Solar Cells	8	Có	Kì yếu khoa học "Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications X"			1 338-342	06/2019
24	Ảnh hưởng của tỉ lệ si/ge lên tốc độ tái hợp của các hạt tải điện trong tinh thể nano SiGe	2	Có	Kì yếu Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc 2019			1 553-556	11/2019
25	Photoluminescence enhancement OF Er <sup>3+</sup> -DOPED ZnO/SiO <sub>2</sub> nanocomposites fabricated through two-step synthesis	6	Có	Optical Materials	Uy tín - ISI $IF: IF = 3.908, Q2$	12	92 262-266	06/2019
26	N-type silicon nanowires prepared by silver metal-assisted chemical etching: Fabrication and optical properties	6	Có	Materials Science in Semiconductor Processing	Uy tín - ISI $IF: IF = 4.1; Q1$	19	90 198-204	01/2019
27	Er-doped SiGe nanocrystals in SiO <sub>2</sub> matrix: fabrication and optical properties	4	Có	The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology			1 185-188	11/2019

28	Heating and quantum effects in Ge nanocrystals dispersed in SiO <sub>2</sub> prepared by co-sputtering method	3	Không	The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology			1 98-101	11/2019
29	Sự phát quang của dây nano si chế tạo bằng phương pháp ăn mòn hóa học có sự trợ giúp của kim loại ag - Mace	5	Có	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019			2 831-834	11/2019
30	Absorption of Si, Ge, and SiGe alloy nanocrystals embedded in SiO <sub>2</sub> matrix	5	Không	Journal of Applied Physics	Uy tín - ISI IF: IF = 3.2; Q2	5	127 114301	03/2020
31	Synthesis and Photoluminescence Properties of Deep-Red-Emitting CaYAlO <sub>4</sub> :Cr <sup>3+</sup> Phosphors	10	Không	Journal of electronic materials	Uy tín - SCIE IF: IF = 1.8; Q2	9	49, 12, 7464-7471	12/2020
32	Photon absorption and scattering of Ge nanocrystals embedded in SiO <sub>2</sub> prepared by co-sputtering	5	Có	Physica B: Condensed Matter	Uy tín - ISI IF: IF = 2.8; Q2		600 412520	01/2021
33	Application of Pump-Probe Technique for Tracking of Charge Carrier Relaxation In Nanostructured Semiconductors	1	Có	VNU Journal of Science: Mathematics-Physics			37, 1, 31-37	03/2021
34	Decisive role of dopants in the	8	Có	Optical Materials	Uy tín - ISI IF: IF =	5	121 111632	11/2021

	optical properties of vertically aligned silicon nanowires prepared by metal-assist chemical etching				3.908, Q2			
35	Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Dây Nano Si Chế Tạo Bằng Phương Pháp Ăn Mòn Điện Hóa Có Sự Trợ Giúp Của Kim Loại	3	Có	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2021			1 363-366	08/2022
36	Thiết kế và chế tạo hệ ăn mòn điện hóa tích hợp điều khiển bo mạch arduino	7	Có	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2021			1 289-292	08/2022
37	Far-red-emitting Cr <sup>3+</sup> -doped CaAl <sub>12</sub> O <sub>19</sub> phosphors with excellent color purity and good quantum efficiency for plant growth LEDs	15	Không	Optical Materials	Uy tín - ISI IF: IF = 3.908, Q2	9	133 113002	11/2022
38	Effective surface area of the Si nanowires prepared by metal-assisted chemical etching method	6	Có	The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology			1 327-330	11/2022
39	High-quality optically defect-free 1D ZnS nanostructures by a modified	9	Không	Optical Materials	Uy tín - ISI IF: IF = 3.902, Q2	10	124 111963	01/2022

	thermal evaporation method							
40	Understanding ZnO surface defects from first-principles simulation	2	Không	Surface Science	Uy tín - SCI <i>IF: IF = 1.9, Q3</i>	3	732 122272	06/2023
41	Low threshold room-temperature lasing emission from high-crystalline ZnS nanowires and nanobelts	10	Không	Applied Physics Letters	Uy tín - ISI <i>IF: IF = 3.7; Q1</i>		123 151107	10/2023
42	Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang BaSrAl <sub>2</sub> SiO <sub>7</sub> pha tạp x%Ce <sup>3+</sup> ứng dụng cho WLED chất lượng cao	4	Có	Ki yếu Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần XIII			1 207- 210	11/2023

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 10 ( [9] [10] [14] [15] [17] [21] [25] [26] [32] [34] )

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

T	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
Không có						

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế\*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

*Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.*

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:


**C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:**

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ngô Ngọc Hà